

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»**

Направление подготовки/специальность: 11.04.04 Электроника и нанoeлектроника

Наименование образовательной программы: Полупроводниковые материалы и структуры

Уровень образования: высшее образование - магистратура

Форма обучения: Очная

**Оценочные материалы
по дисциплине
Технология полупроводниковых приборов и интегральных схем**

**Москва
2024**

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Разработчик

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Холодный Д.С.
	Идентификатор	R0bac9dac-KholodnyDS-6393810d

Д.С.
Холодный

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Холодный Д.С.
	Идентификатор	R0bac9dac-KholodnyDS-6393810d

Д.С.
Холодный

Заведующий
выпускающей
кафедрой

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Славинский А.З.
	Идентификатор	R99b3b9ab-SlavinskyAZ-c08f5214

А.З.
Славинский

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки: достижения обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины.

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Формируемые у обучающегося компетенции:

1. ПК-1 Способен проводить и разрабатывать технологические процессы изготовления материалов и изделий микро- и нанoeлектроники с заданными свойствами

ИД-2 Умеет выбирать перспективные материалы микро- и нанoeлектроники

2. ПК-3 способен осуществлять разработку пооперационного маршрута изготовления нанoeлектронных изделий в составе проектной группы

ИД-4 Определение порядка, вида и технологических параметров операций

и включает:

для текущего контроля успеваемости:

Форма реализации: Компьютерное задание

1. КМ-8 Тест «Современные методы литография» (Контрольная работа)

Форма реализации: Письменная работа

1. КМ-1 1 Тест «Механическая обработка полупроводников. Маркировка слитков Ge, Si» (Контрольная работа)

2. КМ-2 Контрольная работа «Химическая обработка поверхности полупроводников. Трансмутационное легирование слитков Si» (Контрольная работа)

3. КМ-4 Тест «Газовая и жидкостная эпитаксия слоёв кремния» (Контрольная работа)

4. КМ-5 Тест «Получение р-п переходов методом диффузии» (Контрольная работа)

5. КМ-6 Контрольная работа «Расчет диффузионных параметров» (Контрольная работа)

6. КМ-7 Контрольная работа «Получение р-п переходов методом ионного легирования» (Контрольная работа)

Форма реализации: Проверка задания

1. КМ-3 Контр. работа «Получение диэлектрических слоев на поверхности полупроводников.» (Контрольная работа)

БРС дисциплины

1 семестр

Раздел дисциплины	Веса контрольных мероприятий, %			
	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3
	Срок КМ:	4	8	15
1. Основные положения и этапы развития микроэлектроники. Физические основы и методы механической обработки полупроводниковых материалов				
1. Основные положения и этапы развития микроэлектроники. Физические основы и методы механической обработки		+		

полупроводниковых материалов			
2. Поколения приборов электронной техники. Этапы развития микроэлектроники. Правило Мура. Понятие минимального топологического размера. Физические основы шлифования и полирования: хрупкое разрушение и пластическая деформация, создание технологических условий для реализации этих процессов.		+	
2. Маркировка слитков Ge и Si. Трансмутационное легирование слитков Si. Получение сплавных p – n переходов и создание омических контактов			
2. Маркировка слитков Ge и Si. Трансмутационное легирование слитков Si. Получение сплавных p – n переходов и создание омических контактов		+	
3. Химическая, электрохимическая, плазмохимическая, газовая обработка полупроводниковых пластин.			
3. Химическая, электрохимическая, плазмохимическая, газовая обработка полупроводниковых пластин.			+
Вес КМ:	30	30	40

2 семестр

Раздел дисциплины	Веса контрольных мероприятий, %					
	Индекс КМ:	КМ-4	КМ-5	КМ-6	КМ-7	КМ-8
	Срок КМ:	2	4	8	12	15
4. Защитные диэлектрические плёнки в планарной технологии						
4. Защитные диэлектрические плёнки в планарной технологии		+	+	+		
5. Получение полупроводниковых структур методом эпитаксии						
5. Получение полупроводниковых структур методом эпитаксии			+			
6. Планарная технология. Получение p-n переходов методом диффузии.						
6. Планарная технология. Получение p-n переходов методом диффузии.			+	+		
7. Ионное легирование полупроводниковых пластин. Режимы отжига						
7. Ионное легирование полупроводниковых пластин. Режимы отжига					+	
8. Фотолитография, иммерсионная литография, рентгено- и электронная литография.						
8. Фотолитография, иммерсионная литография, рентгено- и электронная литография.					+	+
Вес КМ:		20	20	20	20	20

\$Общая часть/Для промежуточной аттестации\$

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Индекс компетенции	Индикатор	Запланированные результаты обучения по дисциплине	Контрольная точка
ПК-1	ИД-2ПК-1 Умеет выбирать перспективные материалы микро- и нанoeлектроники	Знать: этапы подготовки поверхности полупроводниковой подложки свойства абразивных материалов при обработки поверхности полупроводниковой подложки методы контроля поверхности полупроводниковой подложки свойства полупроводников и материалов, используемых при производстве приборов и интегральных схем. Уметь: приготовить абразивный материал для шлифовки и полировки поверхности полупроводниковой подложки	КМ-1 1 Тест «Механическая обработка полупроводников. Маркировка слитков Ge, Si» (Контрольная работа) КМ-2 Контрольная работа «Химическая обработка поверхности полупроводников. Трансмутационное легирование слитков Si» (Контрольная работа) КМ-3 Контр. работа «Получение диэлектрических слоев на поверхности полупроводников.» (Контрольная работа) КМ-4 Тест «Газовая и жидкостная эпитаксия слоёв кремния» (Контрольная работа) КМ-5 Тест «Получение р-п переходов методом диффузии» (Контрольная работа) КМ-6 Контрольная работа «Расчет диффузионных параметров» (Контрольная работа) КМ-7 Контрольная работа «Получение р-п переходов методом ионного легирования» (Контрольная работа)

		осуществлять контроль этапов подготовки поверхности полупроводниковой подложки Выбрать метод контроля основных параметров поверхности полупроводниковой подложки обосновывать выбор материалов, необходимых для производства приборов и ИС	
ПК-3	ИД-4 _{ПК-3} Определение порядка, вида и технологических параметров операций	Знать: технологические методы и режимы изготовления изделий микро- и нанoeлектроники Уметь: выбирать технологические режимы производства приборов и ИС	КМ-5 Тест «Получение р-п переходов методом диффузии» (Контрольная работа) КМ-7 Контрольная работа «Получение р-п переходов методом ионного легирования» (Контрольная работа) КМ-8 Тест «Современные методы литография» (Контрольная работа)

II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

1 семестр

КМ-1. КМ-1 1 Тест «Механическая обработка полупроводников. Маркировка слитков Ge, Si»

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 30

Процедура проведения контрольного мероприятия: Студенты в аудитории, в течении 1 часа 30 минут, письменно выполняют задание по тестированию

Краткое содержание задания:

Студенты должны выбрать правильные ответы и письменно обосновать свой выбор

Контрольные вопросы/задания:

Знать: методы контроля поверхности полупроводниковой подложки	1. Сколько этапов развития микроэлектроники имело место? 1. Два этапа. 2. Три этапа. 3. Пять этапов. 2. Сколько технологических операций содержит подготовка полупроводниковых пластин? 1. Две операции. 2. Три операции. 3. Четыре операции. 3. Сколько видов абразивных материалов применяют при подготовке полупроводниковых пластин? 1. Два вида. 2. один вид. 3. три вида.
---	---

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: 1

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: 2

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: 3

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "не зачтено" выставляется если задание не выполнено в отведенный срок или результат не соответствует заданию

КМ-2. КМ-2 Контрольная работа «Химическая обработка поверхности полупроводников. Трансмутационное легирование слитков Si»

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 30

Процедура проведения контрольного мероприятия: Студенты в аудитории, в течении 1 часа 30 минут, письменно выполняют задание по контрольной работе

Краткое содержание задания:

3

Контрольные вопросы/задания:

Знать: свойства абразивных	1.2
материалов при обработки	2.2
поверхности полупроводниковой	3.2
подложки	

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: 1

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: 2

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: 3

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "не зачтено" выставляется если задание не выполнено в отведенный срок или результат не соответствует заданию

КМ-3. КМ-3 Контр. работа «Получение диэлектрических слоев на поверхности полупроводников.»

Формы реализации: Проверка задания

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 40

Процедура проведения контрольного мероприятия: 3

Краткое содержание задания:

3

Контрольные вопросы/задания:

Знать: свойства	1.3
полупроводников и материалов,	2.3
используемых при производстве	3.3
приборов и интегральных схем.	

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

2 семестр

КМ-4. КМ-4 Тест «Газовая и жидкостная эпитаксия слоёв кремния»

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20

Процедура проведения контрольного мероприятия: 4

Краткое содержание задания:

4

Контрольные вопросы/задания:

Знать: этапы подготовки	1.4
поверхности полупроводниковой подложки	2.4

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-5. КМ-5 Тест «Получение p-p переходов методом диффузии»

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20

Процедура проведения контрольного мероприятия: 5

Краткое содержание задания:

5

Контрольные вопросы/задания:

Знать: этапы подготовки поверхности полупроводниковой подложки	1.5
Знать: технологические методы и режимы изготовления изделий микро- и нанoeлектроники	1.5 2.5
Уметь: Выбрать метод контроля основных параметров поверхности полупроводниковой подложки	1.5

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто, выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-6. КМ-6 Контрольная работа «Расчет диффузионных параметров»

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20

Процедура проведения контрольного мероприятия: 6

Краткое содержание задания:

6

Контрольные вопросы/задания:

Знать: этапы подготовки	1.6
-------------------------	-----

поверхности полупроводниковой подложки	
Уметь: обосновывать выбор материалов, необходимых для производства приборов и ИС	1.6 2.6

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-7. КМ-7 Контрольная работа «Получение р-п переходов методом ионного легирования»

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20

Процедура проведения контрольного мероприятия: 7

Краткое содержание задания:

7

Контрольные вопросы/задания:

Уметь: осуществлять контроль этапов подготовки поверхности полупроводниковой подложки	1.7
Уметь: приготовить абразивный материал для шлифовки и полировки поверхности полупроводниковой подложки	1.7
Уметь: выбирать технологические режимы производства приборов и ИС	1.7

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-8. КМ-8 Тест «Современные методы литография»

Формы реализации: Компьютерное задание

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20

Процедура проведения контрольного мероприятия: 8

Краткое содержание задания:

8

Контрольные вопросы/задания:

Уметь:	выбирать	1.8
технологические	режимы	2.8
производства приборов и ИС		3.8

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1 семестр

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Пример билета

Вопрос 1. Этапы развития микроэлектроники. Правило Мура?

Вопрос 2. Технология газофазной эпитаксии?

Процедура проведения

В определённый день и время, установленные учебным управлением, студенты собираются в аудитории, указанной в расписании, для проведения зачета. Условием допуска на зачет является выполнение всех пяти контрольных мероприятий (КМ), указанных в РПД и в системе БАРС. Студент сам берет вариант зачета не видя его содержания. Далее подготовка к ответу на вопросы в течении 30 минут и ответ преподавателю в течении 15 минут. На основании ответа преподаватель определяет оценку по пяти балльной системе.

1. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов освоения дисциплины

1. Компетенция/Индикатор: ИД-2_{ПК-1} Умеет выбирать перспективные материалы микро- и нанoeлектроники

Вопросы, задания

1. Этапы развития микроэлектроники. Правило Мура?
2. Определение критического размера абразивного зерна?
- 3.3 Виды и свойства абразивных материалов?
- 4.4 Способы резания слитков на пластины и пластин – на кристаллы?
- 5.5 Методы маркировки слитков Ge, Si и эпитаксиальных структур?
- 6.6 Лазерное легирование как метод сплавления?
- 7.14 Электрохимическое травление кремния?
8. Особенности окисления в сухом и влажном кислороде?

Материалы для проверки остаточных знаний

1.1 Сколько определено основных этапов развития микроэлектроники?

Ответы:

- 1 1. Два этапа.
2. Три этапа.
3. Пять этапов.

Верный ответ: 1 2. Три этапа.

2.2 Сколько параметров характеризуют абразивные материалы?

Ответы:

- 2 1. Три параметра.
2. Четыре параметра.
3. Пять параметров.

Верный ответ: 2 2. Четыре параметра.

3.3 Что понимают под твердостью абразивного материала?

Ответы:

- 3 1. Способность сопротивляться вдавливанию
2. Получать остаточные деформации.

3. Невозможность нанесения царапины.

Верный ответ: 3 1. Способность сопротивляться вдавливанию

4.4 Какие способы используют для резки монокристаллических слитков?

Ответы:

4 1. Резка диском с алмазной кромкой.

2. Резка металлическими полотнами, с применением абразива.

3. Резка с помощью ультразвука.

Верный ответ: 4 1. Резка диском с алмазной кромкой. 2. Резка металлическими полотнами, с применением абразива.

5.5 Какие операции входят в отмывку полупроводниковых подложек?

Ответы:

5 1. Обезжиривание в органических растворителях.

2. Промывка в кислотном растворе

3. Промывка в особо чистой воде.

Верный ответ: 5 1. Обезжиривание в органических растворителях. 3. Промывка в особо чистой воде.

6.6 Какая реакция происходит при электрохимической обработки полупроводниковых пластин?

Ответы:

6 1. Восстановительная.

2. Окислительная.

3. Окислительно - восстановительная.

Верный ответ: 6 3. Окислительно - восстановительная

7.7 Какие ионы применяют при ионно-плазменной обработки полупроводниковых материалов?

Ответы:

7 1. Ионы инертного газа.

2. Поток ионов углерода.

3. Поток ионов кислорода.

Верный ответ: 7 1. Ионы инертного газа.

8.8 Для чего используется плазмохимическая обработка подложек?

Ответы:

8 1. Для удаления загрязнений.

2. Для удаления поверхностного слоя материала подложки.

3. Для уменьшения дислокаций на поверхности.

Верный ответ: 8 2. Для удаления поверхностного слоя материала подложки.

2. Компетенция/Индикатор: ИД-4_{ПК-3} Определение порядка, вида и технологических параметров операций

Вопросы, задания

1.7 Влияние формы р-п перехода на его электрические характеристики (на примере точечного р-п перехода)?

2.8 Определение омических контактов и роль сплавления при создании омических контактов?

3.9 Методы получения и контроль качества деионизованной воды?

4.10 Обезжиривание кремниевых пластин и травление в жидких травителях?

5.11 Технологический процесс электрохимической обработки?

6.12 Ионно-плазменная обработка полупроводниковых материалов?

7.13 Газовая обработка кремниевых пластин?

Материалы для проверки остаточных знаний

1.9 Каким методом получают особо чистую воду?.

Ответы:

9 1. Методом ионного обмена.

2. Методом многократной фильтрации.

3. Методом химической очистки.

Верный ответ: 9 1. Методом ионного обмена.

2.10 Сколько существует основных методов эпитаксии?

Ответы:

10 1. Три метода.

2. Пять методов.

3. Два метода.

Верный ответ: 10 1. Три метода.

3.11 Какое явление лежит в основе гидридного метода эпитаксии кремния?

Ответы:

11 1. Явление осаждения.

2. Явление диффузии.

3. Явление автоэпитаксии.

Верный ответ: 11 3. Явление автоэпитаксии.

4.12 На каких подложках производится гетероэпитаксия кремния?

Ответы:

12 1. На сапфире.

2. На германии.

3. На кварце.

4. На шпинели.

Верный ответ: 12 1. На сапфире. 4. На шпинели.

5.13 Сколько методов легирования применяют при легировании эпитаксиальных слоев?

Ответы:

13 1. Два метода.

2. Три метода.

3. Пять методов.

Верный ответ: 13 2. Три метода.

6.14 Какой параметр определяет пригодность эпитаксиального слоя?

Ответы:

14 1. Количество дислокаций.

2. Толщина слоя.

3. Напряжение пробоя слоя.

Верный ответ: 14 2. Толщина слоя.

7.15 Сколько методов контроля эпитаксиальных слоёв используют на практике?

Ответы:

15 1. Два метода.

2. Четыре метода.

3. Пять методов.

Верный ответ: 15 2. Четыре метода.

II. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы даны верно, четко сформулированные особенности практических решений

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. Основная часть задания выполнена верно.

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Работа не выполнена или выполнена преимущественно неправильно

III. Правила выставления итоговой оценки по курсу

стандартные

2 семестр

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Пример билета

22 Вопрос 1. Создание р-п переходов методом диффузии?

Вопрос 2. Фотолитография в производстве полупроводниковых приборов?

Процедура проведения

22 В определённый день и время, установленные учебным управлением, студенты собираются в аудитории, указанной в расписании, для проведения экзамена. Условием допуска экзамен является выполнение всех контрольных мероприятий (КМ), указанных в РПД и в системе БАРС. Студент сам берет (вытаскивает) вариант экзаменационного билета не видя его содержания. Далее подготовка к ответу на вопросы в течении 30 минут и ответ преподавателю в течении 15 минут. На основании ответа преподаватель определяет оценку по пяти бальной системе.

I. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов освоения дисциплины

1. Компетенция/Индикатор: ИД-2_{ПК-1} Умеет выбирать перспективные материалы микро- и нанoeлектроники

Вопросы, задания

1.1-1 Механизмы и основные уравнения диффузии?

2.1-2 Диффузия из бесконечного и ограниченного источников?

3.1-3 Распределение примесей в многослойной диффузионной структуре?

4.1-4 Распределение примесей в реальных диффузионных структурах?

5.1-5 Основные источники легирующих примесей?

6.1-6 Технологические методы диффузии и оборудование?

Материалы для проверки остаточных знаний

1.1-1 Сколько этапов фотолитографии существует в технологическом процесс?

Ответы:

- 1-1 1. Три этапа
2. Пять этапов.
3. Шесть этапов
Верный ответ: 1-1 2. Пять этапов.
- 2.1-2 Какие современные технологические методы, позволяют уменьшать топологический размер?
Ответы:
1-2 1. Электронная литография.
2. Метод диффузии.
3. Метод ионного легирования.
Верный ответ: 1-2 1. Электронная литография.
- 3.1-3 В чем основное достоинство в создании гетеропереходов?
Ответы:
1-3 1. Способ уменьшения топологических размеров.
2. Создание р-п переходов.
3. Создание контактов для «мелких» р-п переходов.
Верный ответ: 1-3 1. Способ уменьшения топологических размеров.
- 4.1-4 Как происходит перевод примеси в электрически активное состояние?
Ответы:
1-4 1. Путем отжига
2. С помощью имплантации.
3. С помощью аморфизации.
Верный ответ: 1-4 1. Путем отжига
- 5.1-5 Каким методом производится создание самосовмещенного изолированного электрода?
Ответы:
1-5 1. Методом диффузии.
2. Методом ионного легирования.
3. Методом фотолитографии.
Верный ответ: 1-5 2. Методом ионного легирования.
- 6.1-6 От чего зависит температуры отжига полупроводника?
Ответы:
1-6 1. От фазового состояния полупроводника.
2. От количества структурных нарушений в полупроводнике.
3. От температуры окружающей среды.
Верный ответ: 1-6 2. От количества структурных нарушений в полупроводнике.
- 7.1-15 Какие задачи решают при проведении расчетов диффузионных структур?
Ответы:
1-15 1. Определение профиля распределения концентрации примеси.
2. Определение режима процесса диффузии.
3. Определение количества структурных несовершенств.
Верный ответ: 1-15 1. Определение профиля распределения концентрации примеси.
2. Определение режима процесса диффузии.

2. Компетенция/Индикатор: ИД-4_{ПК-3} Определение порядка, вида и технологических параметров операций

Вопросы, задания

- 1.1-7 Методы контроля диффузионных структур?
2.1-8 Достоинства и ограничения метода ионного легирования?
3.1-9 Распределение ионов в полупроводниковых мишенях?
4.1-10 Распределение ионов в мишени при наличии каналирования?

- 5.1-11 Зависимость температуры отжига от количества структурных нарушений в полупроводнике?
- 6.1-12 Создание самосовмещенного изолированного электрода методом ИЛ?
- 7.1-13 Создание контактов для «мелких» р-п переходов с помощью ионной имплантации?
- 8.1-14 Фотолитография в производстве полупроводниковых приборов?
- 9.1-15 Основные этапы фотолитографии: обработка поверхности, нанесение, сушка, задубливание и удаление фоторезиста?

Материалы для проверки остаточных знаний

- 1.1-7 Каким методом производится создание контактов для «мелких» р-п переходов?

Ответы:

- 1-7 1. Методом ионного легирования.

2. Методом диффузии.

3. Методом иммерсионной литографии

Верный ответ: 1-8 1. Методом ионного легирования

- 2.1-8 Какой технологический процесс является первым этапом в фотолитографии?

Ответы:

- 1-8 1. Этап резки на пластины.

2. Этап обработки поверхности.

3. Этап экспонирования.

Верный ответ: 1-9 2. Этап обработки поверхности.

- 3.1-9 Какой технологический процесс является вторым этапом в фотолитографии?

Ответы:

- 1-9 1. Этап экспонирования.

2. Этап нанесения фоторезиста.

3. Этап отжига.

Верный ответ: 1-10 2. Этап нанесения фоторезиста.

- 4.1-11 Какие фоторезисты применяют в фотолитографии?

Ответы:

- 1-10 1. Фоторезисты с большим удельным сопротивлением.

2. Негативные и позитивные фоторезисты.

3. Фоторезисты с малым удельным сопротивлением.

Верный ответ: 1-10 2. Негативные и позитивные фоторезисты.

- 5.1-11 Какой технологический процесс является завершающим этапом в фотолитографии?

Ответы:

- 1-11 1. Удаление фоторезиста.

2. Задубливание фоторезиста.

3. Процесс сушки.

Верный ответ: 1-11 1. Удаление фоторезиста.

- 6.1-12 Какие дефекты образуются в диффузионных структурах?

Ответы:

- 1-12 1. Точечные дефекты.

2. Образование дислокаций и осаждение примесей.

3. Объемные дефекты.

Верный ответ: 1-12 2. Образование дислокаций и осаждение примесей.

- 7.1-13 В чем состоит метод ионной имплантации?

Ответы:

- 1-13 1. В бомбардировке пучками ускоренных ионов.

2. В протекании химических реакций.

3. В радиационной обработке поверхности полупроводника.

Верный ответ: 1-13 1. В бомбардировке пучками ускоренных ионов.

8.1-14 Сколько критериев применимости фоторезистов применяют на практике?

Ответы:

1-14 1. Три критерия.

2. Пять критериев.

3. Восемь критериев.

Верный ответ: 1-14 2. Пять критериев.

II. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы даны верно, четко сформулированные особенности практических решений

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. Основная часть задания выполнена верно.

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Работа не выполнена или выполнена преимущественно неправильно

III. Правила выставления итоговой оценки по курсу

стандартные